

КОРПУСА СИЛОВЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ



Предприятие изготавливает металлокерамические корпуса силовых полупроводниковых приборов (мощных диодов, тиристоров, резисторов и IGBT-модулей) в таблеточном и штыревом исполнении.

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ

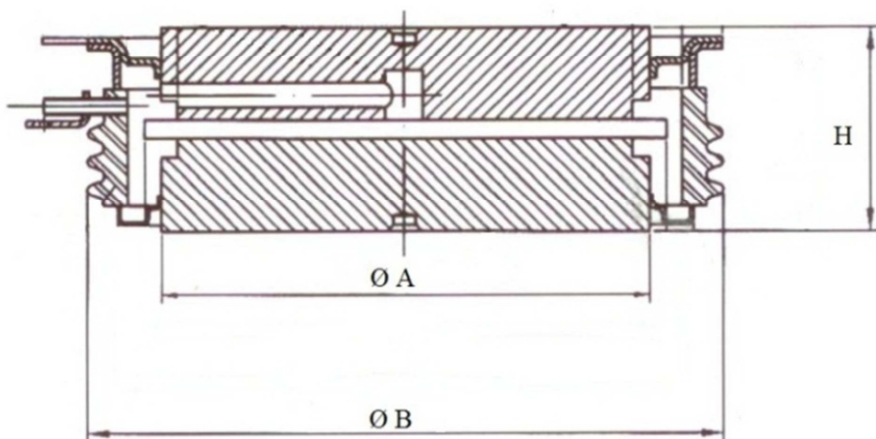


Рис . 1

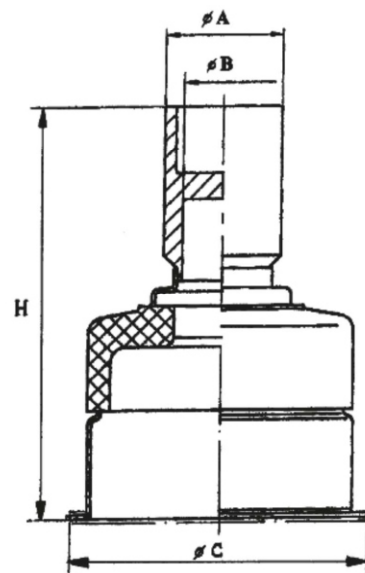


Рис . 2

Структура условного обозначения :

К - корпус керамический ;

КШВ - штыревое исполнение , для диодов;

КШТ - штыревое исполнение , для тиристоров ;

ЖТТ - таблеточные , плоские с выступающими дисками для тиристоров ;

ЖТД - таблеточные , плоские с выступающими дисками для диодов.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпуса силовых полупроводниковых приборов в таблеточном исполнении (рис .1)

Тип корпуса	Размер , мм			Диапазон рабочих температур , °С	Напряжение пробоя , кВ
	Ø А	Ø В	Н		
КЖТД /Т 28 Н	26	45,5	14,5	от -60 до +190	3,0
КЖТД /Т 32 Н	30,5	51	20,7		7,0
КЖТД /Т 40 Н	36	56,5	20,7		9,0
КЖТД /Т 56 Н	49	73	26		
КЖТД /Т 80 Н	70	103,8	27		
Т 111/26	76	104,7	25,5	-	-
D120/26	91,4	117,6	24,9	-	-
T150/26	102	140,5	25	-	-
T172/26	112,5	159	25,8	-	-

Корпуса силовых полупроводниковых приборов в штыревом исполнении (рис .2)

Тип	Размер , мм				Диапазон рабочих температур , °С	Напряжение пробоя , Кв
	ØА	ØВ	ØС	Н		
ККШВ /Т 3-25 Н	14	10,7	32	54	от -70 до +200	5/8
ККШВ /Т 3-30 Н	16	13	40	55		5/10
ККШВ 3-15	10	4,7	22	42		6/10
ККШВ 3-45	25	14	50	51,7		8/10
ККШТЗ -20	12	7	27	47,2		7/10